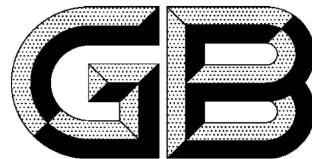


ICS 31.200
L 56



中华人民共和国国家标准

GB/T 39842—2021

集成电路(IC)卡封装框架

Integrated circuit (IC) card packaging framework

2021-03-09 发布

2021-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC 78)归口。

本标准起草单位:山东新恒汇电子科技有限公司。

本标准主要起草人:朱林、邵汉文、王广南、陈铎。

集成电路(IC)卡封装框架

1 范围

本标准规定了集成电路(IC)卡封装框架(以下简称 IC 卡封装框架)的技术要求、检验方法、检验规则、包装、贮存和运输。

本标准适用于 IC 卡封装框架,包括接触式 IC 卡封装框架和非接触式 IC 卡封装框架。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ka:盐雾

GB/T 2423.50 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cy:恒定湿热 主要用于元件的加速试验

GB/T 2423.51—2020 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ke:流动混合气体腐蚀试验

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 13557 印制电路用挠性覆铜箔材料试验方法

GB/T 16545—2015 金属和合金的腐蚀 腐蚀试样上腐蚀产物的清除

GB/T 16649.2 识别卡 带触点的集成电路卡 第 2 部分:触点的尺寸和位置

GB/T 16921—2005 金属覆盖层 覆盖层厚度测量 X 射线光谱法

GB/T 17554.1 识别卡 测试方法 第 1 部分:一般特性测试

GB/T 25933—2010 高纯金

GB/T 25934—2010(所有部分) 高纯金化学分析方法

GB/T 32642—2016 平板显示器基板玻璃表面粗糙度的测量方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

IC 卡封装框架 IC card packaging framework

由绝缘材料与带图形的导电材料叠压而成,是保护芯片的载体,也是芯片与外部设备进行信息交换的接口。

注: 从数据传输方式上可分为单界面接触式 IC 卡封装框架、双界面接触式 IC 卡封装框架和非接触式 IC 卡封装框架。

3.2

单界面接触式 IC 卡封装框架 single side IC card packaging framework

只能以接触的方式,实现与外部设备信息交换的 IC 卡封装框架。

3.3

非接触式 IC 卡封装框架 contactless IC card packaging framework

只能以射频等非接触的方式,实现与外部设备信息交换的 IC 卡封装框架。

3.4

双界面 IC 卡封装框架 double side IC card packaging framework

能够通过物理直接接触的方式实现与外部设备的信息交换,也可以通过射频等非接触的方式实现与外部设备的信息交换的 IC 卡封装框架。

3.5

6Pin IC 卡封装框架 6Pin IC card packaging framework

GB/T 16649.2 规定的 6 个触点(C1、C2、C3、C5、C6、C7)的接触式 IC 卡封装框架。

注: 见图 1、图 3。

3.6

8Pin IC 卡封装框架 8Pin IC card packaging framework

GB/T 16649.2 规定的 8 个触点(C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8)的接触式 IC 卡封装框架。

注: 见图 2、图 4。

3.7

接触面 contact side

接触式 IC 卡封装框架传递信息时,IC 卡封装框架上与外部设备接触的导电体图形表面。

3.8

压焊面 bonding side

接触面的对立面,芯片的承载面,封装面。

3.9

齿孔 sprocket hole

IC 卡封装框架每边一排边孔,设备通过此边孔传送 IC 卡封装框架,并用于定位 IC 卡封装框架的位置。

注: 见图 1、图 2、图 3、图 4。

3.10

接触块 contact pin

位于 IC 卡封装框架接触面上,包含 GB/T 16649.2 规定触点的导电体图形。

注: 见图 1、图 2、图 8、图 9。

3.11

腔孔 cavity

位于 IC 卡封装框架压焊面的绝缘基材上,用于放置芯片的孔。

注: 见图 3、图 4。

3.12

压焊孔 bonding hole

位于 IC 卡封装框架压焊面的绝缘基材上,用于压焊金线的孔。

注: 见图 3、图 4、图 8、图 9。

3.13

压焊点 bonding pad

位于双界面 IC 卡封装框架压焊面上的导电体图形,用于压焊金线的金属点。

注: 见图 5、图 6、图 7、图 9。

3.14

压焊块 bonding block

位于双界面 IC 卡封装框架压焊面上的导电体图形,用于连接卡基天线的金属块。

注: 见图 5、图 6、图 7、图 10。

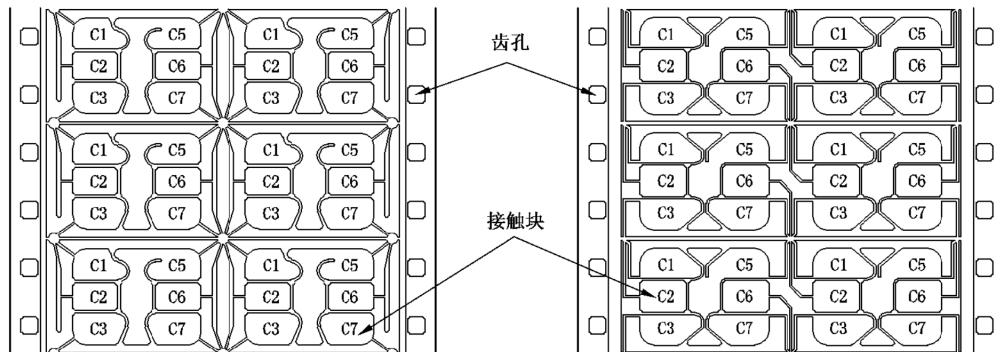


图 1 6Pin 单/双界面 IC 卡封装框架接触面

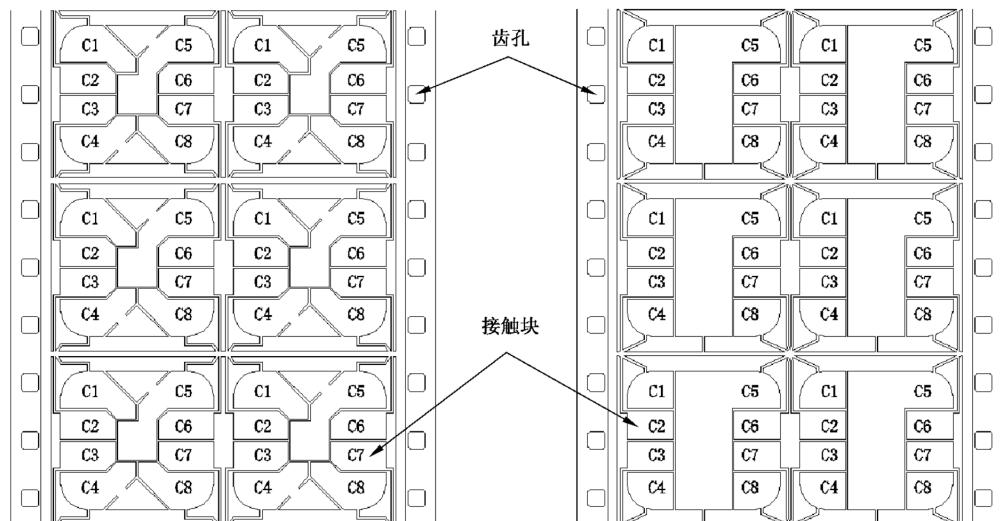


图 2 8Pin 单/双界面 IC 卡封装框架接触面

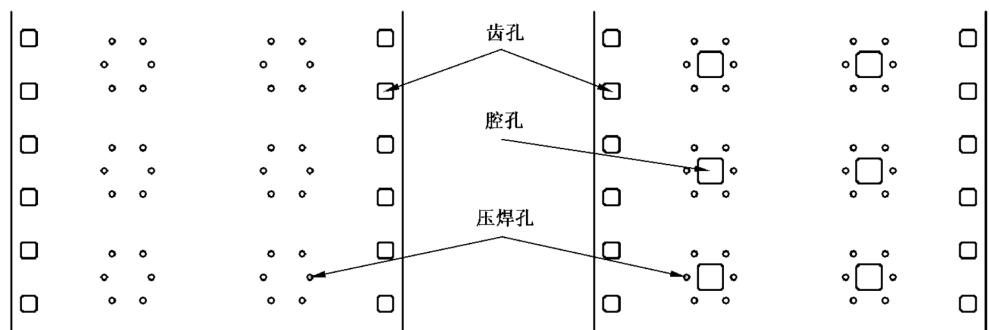


图 3 6Pin 单界面 IC 卡封装框架压焊面

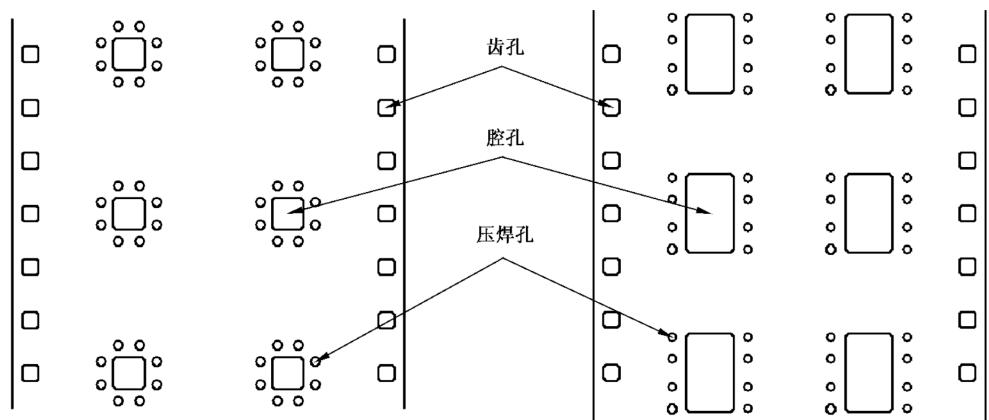


图 4 8Pin 单界面 IC 卡封装框架压焊面

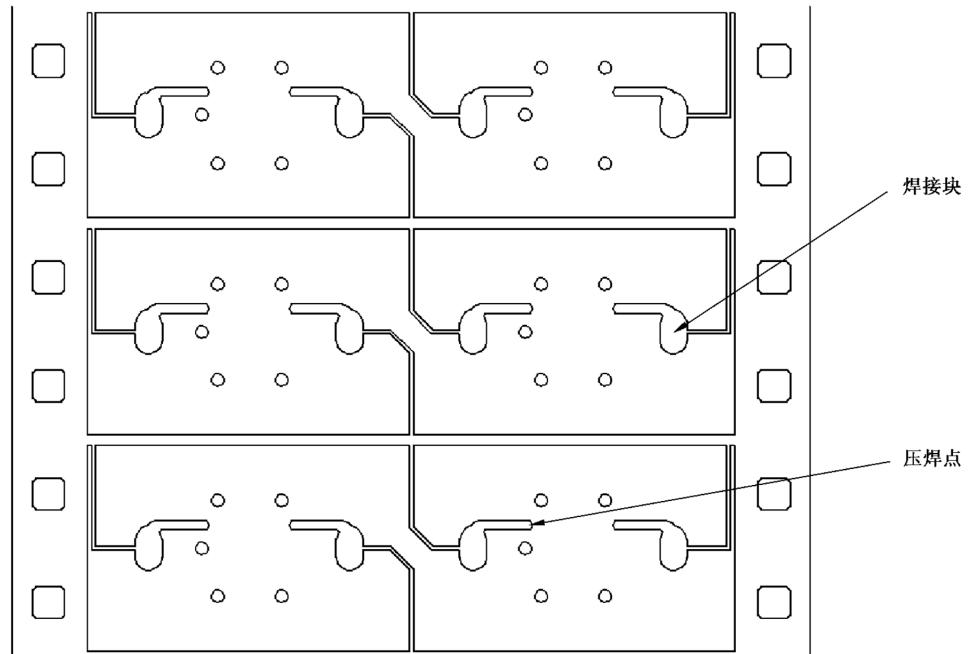


图 5 6Pin 双界面 IC 卡封装框架压焊面

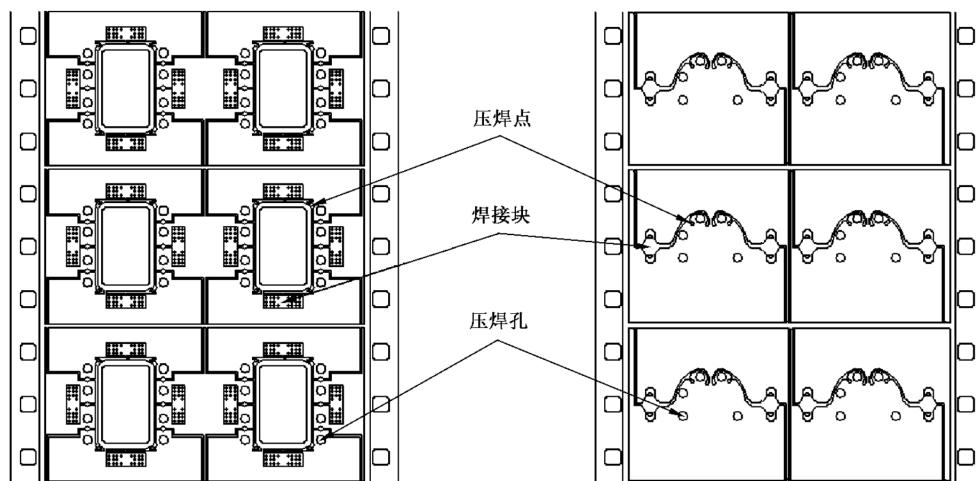


图 6 8Pin 双界面 IC 卡封装框架压焊面

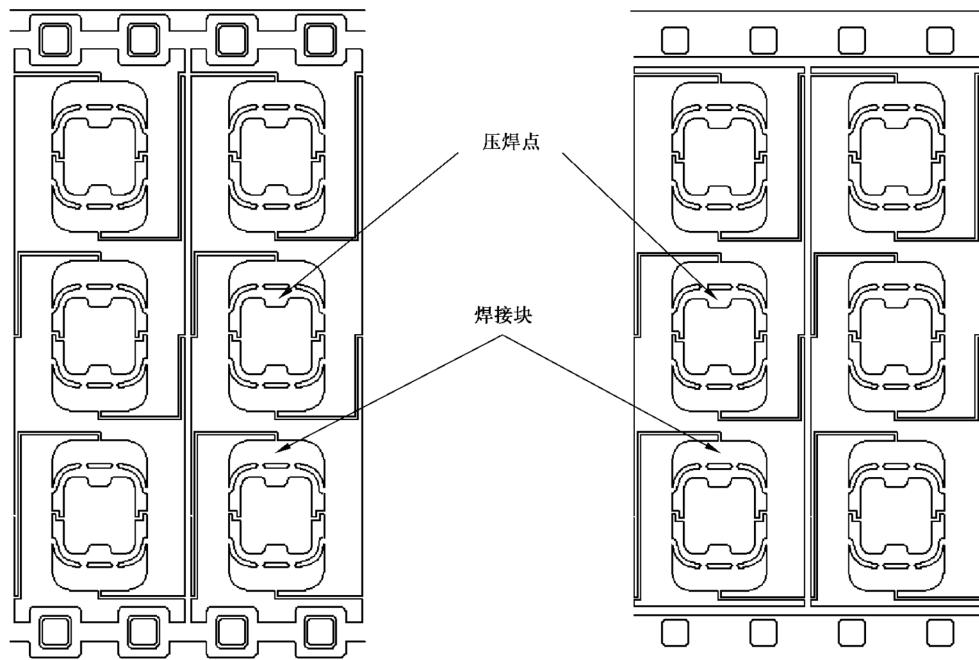


图 7 非接触式 IC 封装框架

4 技术要求

4.1 集成电路(IC)卡封装框架结构

4.1.1 单界面接触式 IC 封装框架截面图见图 8。

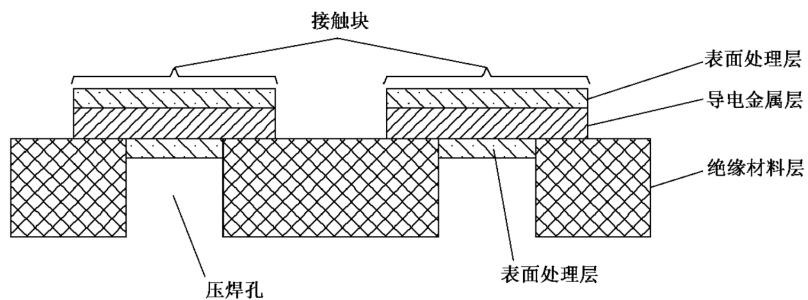


图 8 单界面接触式 IC 封装框架截面图

4.1.2 双界面接触式 IC 封装框架截面图见图 9。

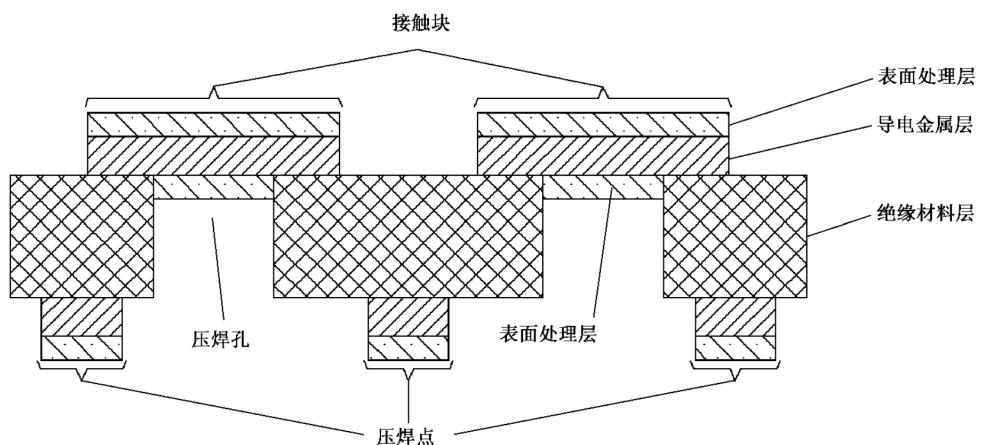


图 9 双界面接触式 IC 封装框架截面图

4.1.3 非接触式 IC 封装框架截面图见图 10。

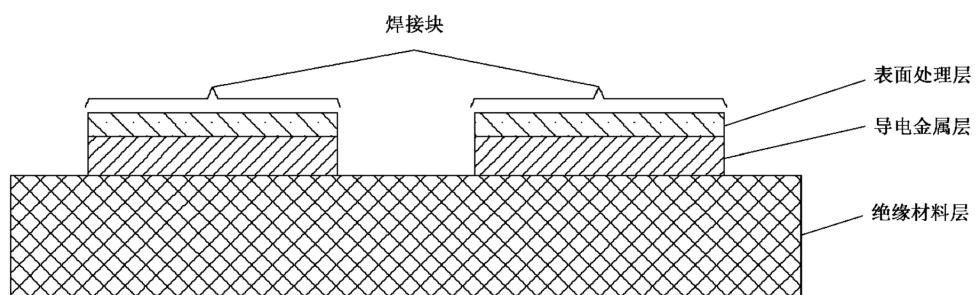


图 10 非接触式 IC 封装框架截面图

4.2 外形尺寸及公差

接触块最小尺寸及位置应符合 GB/T 16649.2 中触点尺寸和位置的规定。

外形尺寸及公差见表 1。

外形尺寸标注示意图见图 11、图 12、图 13。

表 1 外形尺寸及公差

参数	单位	标称值	符号	公差
IC 卡封装框架总厚度	mm	—	—	±0.02
IC 卡封装框架宽度	mm	35	W	±0.075
X 向齿孔中心距离	mm	4.75	S_p	±0.03
Y 向齿孔中心距离	mm	31.83	S_c	±0.02
齿孔径	mm	1.422	S_1, S_2	±0.05
X 向腔孔中心距离	mm	—	C_x	±0.02
Y 向腔孔中心距离	mm	—	C_y	±0.02
齿孔中心到框架边距离	mm	1.585	S_e	±0.075
腔孔到参考点距离	mm	—	B_x, B_y	±0.02
压焊孔、腔径	mm	—	—	±0.02
X 向 36 个齿孔间距	mm	171	L	±0.2
接触块到参考点距离	mm	—	X_1	±0.075
	mm	—	Y_1	±0.075
导线间距	mm	≥0.25	b_2	±0.05
	mm	<0.25	b_1	±0.03
不良品标记孔径	mm	1.5	A	±0.1
不良品标记孔到参考点距离	mm	—	X_2	±0.1
	mm	—	Y_2	±0.1

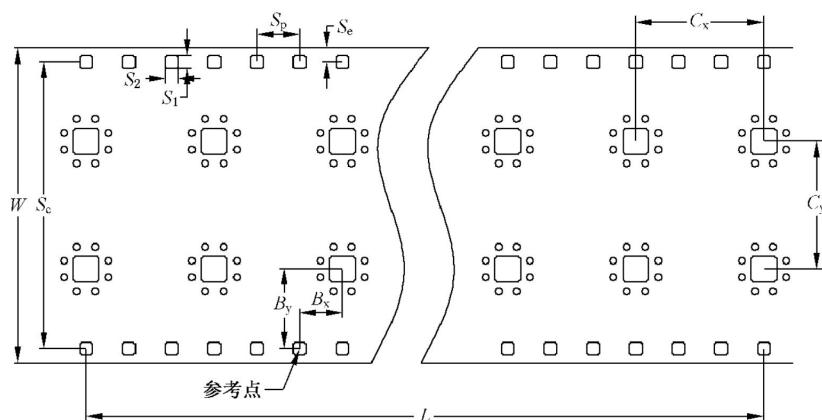


图 11 外形尺寸 1

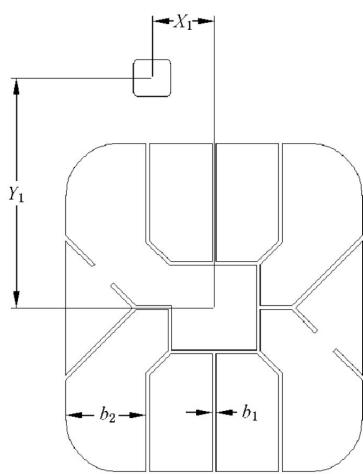


图 12 外形尺寸 2

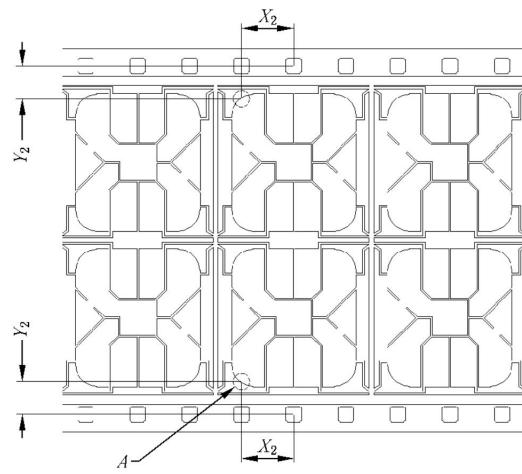


图 13 外形尺寸 3

4.3 镀层

4.3.1 镀层厚度

镀层厚度应符合表 2 的规定。

表 2 镀层厚度

代号	接触面 μm		压焊面(不包括腔孔) μm	
	Ni	Au	Ni	Au
P	1.4~3.0	闪镀(Flash)	3~8	0.2~0.5
T	1.4~3.0	0.013~0.03	3~8	0.2~0.5
M	1.4~3.0	0.025~0.08	3~8	0.2~0.5
L	1.4~3.0	0.030~0.08	3~8	0.2~0.5
S	1.4~3.0	0.050~0.15	3~8	0.2~0.5
D	2.0~6.0	0.060~0.15	3~16	0.2~0.6
G	2.0~6.0	0.100~0.20	3~16	0.3~0.6
W	2.0~6.0	0.150~0.20	3~16	0.35~0.7
其他	按客户要求	按客户要求	按客户要求	按客户要求

4.3.2 金属层表面粗糙度

金属层表面粗糙度应符合表 3 的规定。

表 3 金属层表面粗糙度

参数	指标
接触面金属层粗糙度	Rz (微观不平度十点高度) $< 3 \mu\text{m}$
压焊面金属层粗糙度	Rz (微观不平度十点高度) $\leq 4 \mu\text{m}$

4.3.3 镀金层纯度

镀金层纯度应符合 GB/T 25933—2010 的规定。

4.4 金属层剥离强度

金属层与绝缘层的剥离强度应不小于 1 N/mm。

4.5 外观要求

4.5.1 单个 IC 卡封装框架表面平整度

单个 IC 卡封装框架表面平整度应不大于 50 μm 。

4.5.2 35 mm 宽度 IC 卡封装框架翘曲

35 mm 宽度 IC 卡封装框架翘曲应不大于 1 mm。

4.5.3 压焊孔表面平整度

压焊孔表面平整度应不大于 10 μm 。

4.5.4 腔孔表面平整度

腔孔表面平整度应不大于 30 μm 。

4.5.5 压焊孔、腔孔溢胶最大值

压焊孔、腔孔溢胶最大值 E 应不大于 100 μm , 见图 14。

4.5.6 压焊孔、腔孔毛刺最大值

压焊孔、腔孔毛刺最大值 M 应不大于 100 μm , 见图 15。

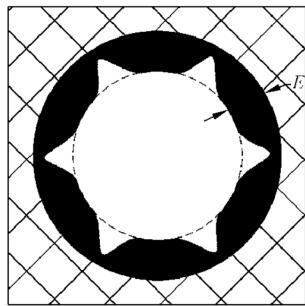


图 14 溢胶示意图

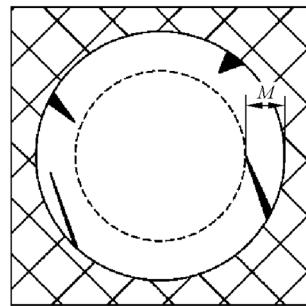


图 15 毛刺示意图

4.5.7 镀层外观

镀层表面应致密、平滑、色泽均匀呈镀层本色, 不准许有起泡、玷污、斑点、水迹、异物、发花、短路、断路等缺陷。应无明显污点、脱落、镀层漏镀、镀层划痕。

4.6 可靠性

4.6.1 耐温性

耐温性应符合表 4 的规定。

表 4 耐温性

项目	试验条件	合格判据
高温锡焊	温度 288 °C±5 °C,持续时间 10 s	导电金属与绝缘材料不分层
温度稳定性	温度 260 °C±5 °C,持续时间 3 min	导电金属与绝缘材料不分层
恒定湿热	温度 85 °C,相对湿度 85%,持续时间 504 h	导电金属与绝缘材料不分层
高压蒸煮	温度 121 °C±2 °C,绝对气压 0.2 MPa,相对湿度 100%,持续时间 24 h	导电金属与绝缘材料不分层 24 h 后金属层剥离强度大于 0.2 N/mm

4.6.2 耐化学性

人工汗液的配制方法应符合 GB/T 3922 的规定。

耐化学性应符合表 5 的规定。

表 5 耐化学性

项目	合格判据
5%氯化钠溶液浸泡 1 min	外观无明显变化
5%乙酸溶液浸泡 1 min	外观无明显变化
5%碳酸钠溶液浸泡 1 min	外观无明显变化
60%乙醇溶液浸泡 1 min	外观无明显变化
10%蔗糖溶液浸泡 1 min	外观无明显变化
Fuel B (ISO 1817)浸泡 1 min	外观无明显变化
50%的乙烯乙二醇浸泡 1 min	外观无明显变化
人造汗液碱溶液浸泡 24 h	外观无明显变化
人工汗液酸溶液浸泡 24 h	外观无明显变化

4.6.3 盐雾

盐雾应符合表 6 的规定。

表 6 盐雾

项目	表面厚度代号	合格判据
盐雾试验(24 h)	全部	水洗后,表面电阻<500 mΩ
盐雾试验(48 h)	P、T	酸洗后,腐蚀点≤100 个/cm ²
盐雾试验(96 h)	M、L、S、D、G、W、其他	酸洗后,腐蚀点≤100 个/cm ²

4.6.4 流动混合气体腐蚀

流动混合气体浓度应符合 GB/T 2423.51—2020 中表 1 方法 1 的规定。

流动混合气体腐蚀 96 h,酸洗后腐蚀点≤100 个/cm²。

5 检验方法

5.1 外观检验方法

5.1.1 检验环境

检验人员在检验 IC 卡封装框架外观时,应在 10 万级的洁净室中,穿无尘衣、戴无尘帽、戴口罩、戴手指套,不能直接用手去触摸 IC 卡封装框架表面,避免因裸手接触造成 IC 卡封装框架污染。

5.1.2 目测方法

IC 卡封装框架检验时,应使用专用的、配有电机和光源的框架检验工作台,工作台应干净,平整。

检验时应在光源下,距 IC 卡封装框架 30 cm~40 cm,眼睛与集成电路(IC)卡封装框架表面保持±30°的角度,进行目测,见图 16。

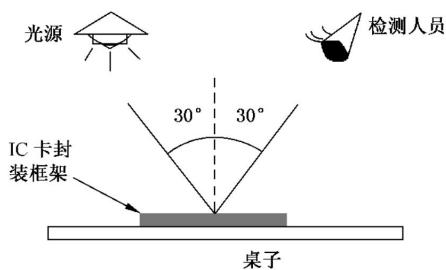


图 16 目测

5.1.3 外观测量方法

外观测量方法按表 7 的规定。

表 7 外观测量方法

检验项目	检验要求章条号	检验方法
外形尺寸及公差	4.2	使用满足测量精度的量具或工具进行测量
镀层厚度	4.3.1	按 GB/T 16921—2005 测量
金属层剥离强度	4.4	按 GB/T 13557 测量
金属层表面粗糙度	4.3.2	按 GB/T 32642—2016 测量
镀金层纯度	4.3.3	按 GB/T 25934—2010 测量

5.2 可靠性检验方法

可靠性检验方法按表 8 的规定。

表 8 可靠性检验方法

检验项目	检验要求章条号	检验方法
耐温性	4.6.1	按附录 A 进行高压蒸煮测试 按 GB/T 2423.2 进行温度稳定性测试 按 GB/T 2423.50 进行恒定湿热测试 按附录 B 进行高温锡焊测试

表 8 (续)

检验项目	检验要求章条号	检验方法
耐化学性	4.6.2	按 GB/T 17554.1 测试
盐雾	4.6.3	按 GB/T 2423.17、GB/T 16545—2015 测试
流动混合气体腐蚀	4.6.4	按 GB/T 2423.51—2020、GB/T 16545—2015 测试

6 检验规则

6.1 检验分类

检验分为：

- a) 出厂检验；
- b) 型式检验。

6.2 出厂检验

6.2.1 检验批

一个检验批应由相同类型，在相同的条件下，采用相同原材料和工艺生产，并在同一时间内提交检验的产品组成。

6.2.2 抽样方案

应按 GB/T 2828.1 规定的一般检查水平Ⅱ和一次正常抽样方案，从提交的检验批中按表 9 规定随机抽取试样。

表 9 抽样

分组	检验项目	检验要求章条号	出厂检验	型式检验
			抽样方案	
A 组	外观要求	4.5	100%	50/0
B 组	外形尺寸及公差	4.2	AQL=0.65	50/0
	镀层厚度	4.3.1		
	金属层剥离强度	4.4		
	金属层表面粗糙度	4.3.2		
	镀金层纯度	4.3.3		
	耐温性	4.6.1		
	耐化学性	4.6.2		
	盐雾	4.6.3		
	流动混合气体腐蚀	4.6.4		

6.2.3 检验程序

应按表 9 规定进行检验。

A组检验100%进行,剔除不合格品;B组检验从通过A组检验的检验批中,按表9规定抽样进行。

6.2.4 判定

一个或多个试样有一项或多项检验未通过表9规定的检验,则判定为不合格。

6.2.5 拒收批

若检验批中不合格品数大于表9中AQL值所对应的允许不合格判定数时,则加倍抽样,对不合格项目进行复检,若复检仍不合格时,则判定该批不合格。

6.3 型式检验

6.3.1 通则

下列情况之一者,应进行型式检验:

- a) 新产品生产试制定型鉴定;
- b) 正式生产后,原材料、工艺等发生较大改变,可能影响产品性能时;
- c) 产品停产3个月及其以上,恢复生产时;
- d) 出厂检验结果与上次检验存在较大差异时。

6.3.2 抽样方案

按表9规定。

6.3.3 检验程序

应按表9规定进行检验。

50个试样先进行A组检验,经A组检验合格后,再进行B组检验。

B组的检验项目应按有关产品规范中的规定进行。

6.3.4 判定

一个或多个试样有一项或多项检验未通过表9规定的检验,则型式试验不合格。

7 包装规格

7.1 包装

IC卡封装框架以卷状的形式,中间加隔离膜进行包装后,再用塑料袋包装进行抽真空。每两卷为一箱,标签标识向上。

注:如有特殊要求,以与客户签订的订单合同为准。

7.2 标签

每盘IC卡封装框架均需带有标签。标签上须标明以下内容:

- a) 制造单位名称(或商标);
- b) 客户产品编号;
- c) 厂内产品编号;
- d) 合格数和缺陷数;
- e) 接头数;
- f) 批号;

- g) 表面处理日期；
- h) 合格章。

8 贮存

IC 卡封装框架原包装密封储存且符合以下贮存条件,保质期 12 个月(从表面处理日期开始):

- a) 温度:20 °C±5 °C。
- b) 相对湿度:50%±10%。
- c) 无腐蚀性污染(如 H₂S、SO₂、NaCl)。

9 运输

IC 卡封装框架在运输装卸过程中,外包装不应破损,注意轻拿轻放,不能投掷、重压,避免日晒雨淋。

附录 A
(规范性附录)
高压蒸煮试验

A.1 目的

在高压蒸汽条件下,以加速的方式评价导电金属层与绝缘材料层的抗潮湿能力。

A.2 设备

- A.2.1 高压蒸汽试验箱,工作区域绝对气压达到 0.2 MPa(2 bar),并有压力和温度指示装置。
- A.2.2 试验箱用水的电阻率应大于 $500 \Omega \cdot m$ 。
- A.2.3 试验箱结构牢固,并有安全装置,以保证试验安全进行。
- A.2.4 放置试样架在实验过程中不应被水淹没,同时水也不能溅到试样上。

A.3 试验条件

试验条件如下:

- a) 试验温度: $121^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$;
- b) 试验压力:绝对气压 0.2 MPa;
- c) 试验湿度:相对湿度 100%;
- d) 试验时间:24 h。

A.4 试验程序

A.4.1 初始检测

对试样进行外观检查(必要时做金相分析),确保导电金属与绝缘材料不分层。

A.4.2 试验方法

将试样放在试验架上,当试验箱的温度、压力满足 A.3 的试验条件时,开始计时,到达设定时间 24 h 后,将试样取出。

A.4.3 恢复

将试样在正常气候条件下恢复 24 h。

A.4.4 最终检测

对试样进行外观(必要时做金相分析)和金属层剥离强度检测。

附录 B
(规范性附录)
高温锡焊试验

B.1 目的

评价导电金属层与绝缘材料层的抗高温焊接的能力。

B.2 设备

B.2.1 具有可控恒温器的电热焊锡槽,容积要能足以保证试样浸入以后,与槽壁槽底的距离不得小于10 mm,焊锡槽里的成分如下:

- a) 锡:59%~60%;
- b) 铅:5%最大;
- c) 铜:1%最大;
- d) 砷:0.05%最大;
- e) 铁:0.02%最大;
- f) 铂:其余部分。

B.2.2 焊料中的杂质(如铝、锌、镉等)含量不得有损于焊料的特性。

B.2.3 所采用的助焊剂为25%的松香、75%的异丙醇,并加入松香含量为0.5%的二甲基氯化物(分析纯)。

B.3 试验条件

试验条件如下:

- a) 试验温度:288 °C±5 °C;
- b) 试验时间:10 s±1 s。

B.4 试验程序

B.4.1 初始检测

按有关规范规定,对试样进行外观检查(必要时做金相分析),确保导电金属与绝缘材料不分层。

B.4.2 试验方法

先将试样浸放入助焊剂中,然后再浸入到焊锡槽内,浸润时间为10±1 s,将试样取出冷却至室温,用适当的溶剂清除掉试样上的助焊剂。

B.4.3 恢复

将试样在正常气候条件下恢复24 h。

B.4.4 最终检测

按有关规范规定,对试样进行外观(必要时做金相分析)检验。

中华人民共和国

国家标准

集成电路(IC)卡封装框架

GB/T 39842—2021

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.spc.org.cn

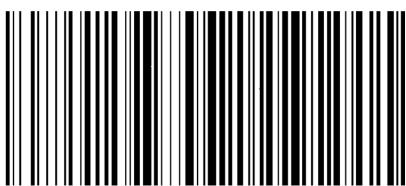
服务热线:400-168-0010

2021年3月第一版

*

书号:155066·1-65122

版权专有 侵权必究



GB/T 39842-2021